



汕头华汕电子器件有限公司

PNP SILICON TRANSISTOR

H5610

对应国外型号
HIT5610

主要用途

作音频放大。

外形图及引脚排列

极限值 (T_a=25)

T _{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T _j ——结温.....	150
P _C ——集电极耗散功率.....	750mW
V _{CB0} ——集电极—基极电压.....	-25V
V _{CEO} ——集电极—发射极电压.....	-20V
V _{EBO} ——发射极—基极电压.....	-5V
I _C ——集电极电流.....	-1A



电参数 (T_a=25)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV _{CB0}	集电极—基极击穿电压	-25			V	I _C =-10 μA, I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	-20			V	I _C =-1mA, I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	-5			V	I _E =-10 μA, I _C =0
I _{CB0}	集电极—基极截止电流			-1	μA	V _{CB} =-20V, I _E =0
H _{FE}	直流电流增益	60		240		V _{CE} =-2V, I _C =-500mA
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压		-0.2	-0.5	V	I _C =0.8A, I _B =-80mA
V _{BE}	基极—发射极电压		-0.8	-1	V	V _{CE} =-2V, I _C =-500mA
f _T	特征频率		360		MHz	V _{CE} =-2V, I _C =-500mA
C _{ob}	共基极输出电容		38		pF	V _{CB} =-10V, I _E =0, f=1MHz

分档及其标志

A	B	C
60—120	85—170	120—240

